

Überleitung Module Nanoelectronic Systems (M.Sc.) von PO 2013 in PO 2024 (Äquivalenztabelle)

Stand: 09.03.2026

identisches Modul: Übernahme komplett wie es ist

nicht identisches Modul - identische Prüfungsleistung (ggf. anderer Name der Prüfungsleistung gemäß neuer PO): Übernahme Modulnote bzw. **nachrangig einzelne Prüfungsleistungen**, Übernahme Fehlversuchszähler

nicht identisches Modul - nicht identische Prüfungsleistung: keine direkte Übernahme Modulnote oder Prüfungsleistungen, keine Übernahme Fehlversuchszähler

--> **Übernahme bestandener Module bzw. nachrangig einzelne Prüfungsleistungen nach Festlegung**
 *--> **nicht bestandene Module/Prüfungsleistungen werden nicht übernommen ("verschwinden")**

für PO 2024 zusätzlich erforderliches Modul

in PO 2024 in einem anderen Bereich verortetes Modul/Lehrveranstaltung/Prüfungsleistung

! Am Ende des Zwangsübertritts nicht "verwertete" Module/Prüfungsleistungen können in den Zusatzbereich gebucht werden.

Fortführung

ÜLM	=	! Wenn das Modul abgeschlossen ist, wird die Modulnote übernommen in das neue Modul. Wenn Modul-Fehlversuche vorliegen, wird der Versuchszähler übernommen.
ÜLPL	=	! Wenn im Modul nur einzelne bestandene Prüfungsleistungen vorliegen, werden nur die Noten dieser Prüfungsleistungen übernommen.
ÜLM*	=>	! Wenn das Modul abgeschlossen ist, wird die Modulnote übernommen in das zugeordnete Modul bzw. über die zugeordnete Bildungsvorschrift verrechnet. *Nicht bestandene Module bzw. der Modul-Fehlversuchszähler werden nicht mitgeführt.
ÜLPL*	=>	! Wenn im Modul nur einzelne bestandene Prüfungsleistungen vorliegen, werden nur die Noten dieser Prüfungsleistungen übernommen bzw. über die zugeordnete Bildungsvorschrift verrechnet. *Nicht bestandene Prüfungsleistungen werden nicht mitgeführt.

zusätzliches, in PO 2024 im Pflichtbereich nicht erforderliches Modul (Wahlmodul oder Zusatzmodul)

Transition from Nanoelectronic Systems (M.Sc.) modules from examination regulations 2013 to examination regulations 2024 (equivalence table)

Date: 9th March, 2026

Identical module: Transfer completely as is

Non-identical module - identical module assessment (possibly different name of the assessment according to new examination regulations): Transfer of module grade or, **subordinately, individual assessments**, transfer of failed attempts counter

Non-identical module - non-identical module assessment: no direct transfer of module grade or assessments, no transfer of failed attempts counter

--> **transfer of passed modules or, subordinately, individual assessments as determined**
 *--> **failed modules/assessments are not transferred ("disappear")**.

additional module required for examination regulation 2024

Module/course/exam located in another area in examination regulation 2024

! Modules/assessments that have not been "utilized" at the end of the compulsory transfer period can be booked in the additional area.

Continuation

ÜLM	=	Continuation/transfer of the module, including all assessment grades and failed attempts. ! When the module is completed, the module grade is transferred to the new module. If there are failed attempts in the module, the attempt counter is transferred.
ÜLPL	=	! If only individual passed assessments are available in the module, only the grades for these assessments are transferred.
ÜLM*	=>	Once the module is completed, the module grade is transferred to the assigned module or calculated using the assigned educational regulations . *Failed modules or the module failure counter are not carried over.
ÜLPL*	=>	If only individual passed examinations are available in the module, only the grades for these examinations are transferred or calculated using the assigned educational regulation. *Failed examinations are not included.

additional module not required in the compulsory area in examination regulation 2024 (required elective module or additional module)

Modul-Nr./CN	Modulname Lehrveranstaltung (Abk. im Stundenplan)	1. Semester	2. Semester	3. Semester	Hinweise zu Prüfungsleistungen	LP	Überleitung	Modulnote	Modul-Nr./CN	Modulname Lehrveranstaltung (Abk. im Stundenplan)	1. Semester	2. Semester	3. Semester	Hinweise zu Prüfungsleistungen	LP	Modulver- antwortlicher
		V/Ü/P	V/Ü/P	V/Ü/P							V/Ü/P	V/Ü/P	V/Ü/P			
NES-11 06 01-19.1	Lab Sessions	0/0/0/3			$M_{alt} = (PL1 + PL2) / 2$	5	ÜL M zweitrangig PL	$M_{neu} = M_{alt}$	INF-NES-C-LabS	Lab Sessions	0/0/4 PL	0/0/2 PL		$M_{neu} = (PL1 + PL2) / 2$	7	Prof. Fetzer
	Robolab	0/0/0/2			PL1 Praktikumsprotokolle		ÜL PL1			Robolab	0/0/4			PL1 Komplexe Leistung 60 h		Fetzer
	Wahl 1 aus 3: Semiconductor Technology Lab oder Hardware/Software Codesign Lab oder Emerging PV Technologies		0/0/0/1		PL2 Praktikumsprotokolle PVL (beide): Sammlung von Übungsaufgaben (Fetzer)		ÜL PL2			Wahl 1 aus 3: Semiconductor Technology Lab oder Hardware/Software Codesign Lab oder Emerging PV Technologies		0/0/2		PL2 Portfolio 30 h		Mikolajick Matus Leo
NES-11 06 02-14.1	Principles of Dependable Systems (Principl. Dep. Syst.)	2/2/0/0			$M_{alt} = PL$	6	ÜL M	$M_{neu} = M_{alt}$	INF-NES-C-CONF	Confidential Computing	2/2/0 PL			$M_{neu} = PL$	6	Prof. Fetzer
		2/2/0/0			PL bei mehr als 5 TN Klausur 90min, bei bis zu 5 TN mdl. PL 30min PVL Übungsaufgaben					Confidential Computing	2/2/0			Klausur 60 min		
NES-12 10 01-14.1	Fundamentals of Estimation and Detection	2/2/0/0			$M = PL$	6			Wahlpflichtbereich							
	Fundamentals of Estimation and Detection (Fund.Estim.Detc)	2/2/0/0			PL Klausur 120min											
NES-12 12 02-19.1	Semiconductor Technology	4/0/0/0	2/0/0/0		$M_{alt} = PL$	9	ÜL M	$M_{neu} = M_{alt}$	Eui-NES-C-SCT	Semiconductor Technology	3/1/0	2/0/0 PL		$M_{neu} = PL$	8	
	Semiconductor Technology 1 (Semicon.Techn.I)	4/0/0/0			PL bei mehr als 20 TN Klausur 120min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 30min					Semiconductor Technology 1 (Semicon.Techn.I)	3/1/0			Klausur 120 min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 30 min		
	Semiconductor Technology 2 (Semicon.Techn.II)		2/0/0/0							Semiconductor Technology 2 (Semicon.Techn.II)		2/0/0				
NES-12 08 02-14.1	Radio Frequency Integrated Circuits		3/1/0/2		$M_{alt} = PL$	7	ÜL M	$M_{neu} = M_{alt}$	Eui-NES-C-RFIC	Radio Frequency Integrated Circuits		3/1/2 PL		$M_{neu} = PL$	8	Prof. Ellinger
	Radio Frequency Integrated Circuits (RadFrealC)		3/1/0/2		PL Klausur 120min					Radio Frequency Integrated Circuits (RadFrealC)		3/1/2		Klausur 120 min		
NES-12 10 03-14.1	Hardware/Software Codesign		2/1/0/0		$M_{alt} = PL$	4	ÜL M	$M_{neu} = M_{alt}$	Eui-NES-C-HwSwC	Hardware/Software Codesign		2/2/0 PL		$M_{neu} = PL$	5	Prof. Fettweis
	Hardware/Software Codesign for Signal Processors (H-/S-Codesign)		2/1/0/0		PL bei mehr als 16 TN Klausur 120 min, bei bis zu 16 TN mdl. PL 20min					Hardware/Software Codesign for Signal Processors (H-/S-Codesign)		2/2/0		Klausur 120 min		
NES-12 ASW-14.1	Academic and Scientific Work			X/X/X/X	ungewichteter Durchschnitt der einzelnen PL	4	ÜL M	$M_{neu} = M_{alt}$	Eui-NES-C-ASW	Academic and Scientific Work			0/0/0 3 SWS Seminare PL	$M_{neu} = PL$	5	Studiendekan
	Wahl 1 aus 3: Paper Reading Group "Seminal Discoveries & Developments" (ASW PapReadGr)			3 SWS	PL siehe Katalog "Akademisches und Wissenschaftliches Arbeiten"					Wahl 1 aus 3: Paper Reading Group "Seminal Discoveries & Developments" [2 Einzelgruppen] (ASW PapReadGr)			3 SWS	Komplexe Leistung 30 h		Schmilt
	Photonic Devices Group (ASW PapReadGr)			3 SWS						Photonic Devices Group (ASW PapReadGr)			3 SWS			Jamshidi
	Nanoelectronic Systems Design Student Conference (ASW NESDSC)			3 SWS						Nanoelectronic Systems Design Student Conference (ASW NESDSC)			3 SWS			Fettweis (Qiaohan Zhang)
NES-12 PW-14.1	Project Work			0/0/1/0	$M_{alt} = (4PL1 + PL2)/5$	10	ÜL M	$M_{neu} = M_{alt}$	Eui-NES-C-PW	Project Work			0/0/0 1 SWS Projekte PL	$M_{neu} = PL$	10	Studiendekan
					PL1 Projektarbeit 36 Tage PL2 Präsentation 15 min									Komplexe Leistung 120 h		

NES-11 06 01-19.1	Lab Sessions Robolab Semiconductor Technology Lab	0/0/0/3 0/0/0/2	 0/0/0/1	M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 Praktikumsprotokolle 140710 PL2 Praktikumsprotokolle 140720 PVL (beide): Sammlung von Übungsaufgaben 140701	5
NES-11 06 01-19.1	Lab Sessions Robolab Photovoltaic Lab (PHY LP HL)	0/0/0/3 0/0/0/2	 V	M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 Praktikumsprotokolle 140710 PL2 Praktikumsprotokolle 140720 PVL (beide): Sammlung von Übungsaufgaben 140701	5
NES-11 06 02-14.1	Principles of Dependable Systems Principles of Dependable Systems (Principl. Dep. Syst.)	2/2/0/0 2/2/0/0		M = PL PL bei mehr als 5 TN Klausur 90min, bei bis zu 5 TN mdl. PL 30min 140910 PVL Sammlung Übungsaufgaben 140901	6
NES-12 12 02-14.1	Semiconductor Technology Semiconductor Technology I (Semicon. Techn. I) Semiconductor Technology II	4/0/0/0 4/0/0/0	2/0/0/1 2/0/0/1	M = PL PL bei mehr als 20 TN Klausur 120 min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 30min 141310	10

Modul-Nr./CN	Modulname Lehrveranstaltung (Abk. im Stundenplan)	1. Semester	2. Semester	3. Semester	Hinweise zu Prüfungsleistungen	LP	Überleitung	Modulnote	Modul-Nr./CN	Modulname Lehrveranstaltung (Abk. im Stundenplan)	1. Semester	2. Semester	3. Semester	Hinweise zu Prüfungsleistungen	LP	Modulver- antwortlicher					
		V/Ü/P	V/Ü/P	V/Ü/P							V/Ü/P	V/Ü/P	V/Ü/P								
NES-30 GLC-14.1	German Language and Culture	0/0/4/0 PL			M _{alt} = PL	4	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-GLC	German Language and Culture	4 SK PL			M _{neu} = PL	5	Frau Ruszo					
	German Language and Culture (Deutsch als Fremdsprache)	0/4/0/0			PL Klausur 90 min								German Language and Culture (Deutsch als Fremdsprache)	0/4/0					Klausur 60 min		
NES-ET-22-E-ICAND	Innovative Concepts for Active Nanoelectronic Devices			4/0/0/2 3PL	M _{alt} = (4PL1 + 4PL2 + 2PL3)/10	7	ÜL M zweitrangig PL	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-ICAND (Eul-ET-E-ICAND)	Innovative Concepts for Active Nanoelectronic Devices			4/1/1 PL	M _{neu} = (PL1 + PL2) / 2	7	Prof. Mikolajick Richter Mikolajick/ Heinzig					
	Materials for Nanoelectronics (Mat.for.Nanoel.)			2/0/0/1	PL1 bei mehr als 20 TN Klausur 90 min, bei bis zu 20 TN mdl. Prüfung 20 min					PL1 Zusatzbereich auf Antrag			Materials for Nanoelectronics (Mat.for.Nanoel.)					2/0/1	PL1 Klausur 120 min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 30 min		
	Innovative Semiconductor Devices			2/0/0/1	PL2 bei mehr als 20 TN Klausur 90 min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 20min					ÜL PL3 PL2 Zusatzbereich auf Antrag	PL2=PL3		Innovative Semiconductor Devices (Innov.Sem.Dev.)					2/1/0	PL2 Portfolio 40 h		
NES-INF-DSE-20-M-SE1	Foundations of Systems Engineering	2/2/0/0			M _{alt} = PL	5	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	INF-NES-E-SE	Systems Engineering	2/2/0 PL			M _{neu} = PL	6	Prof. Fetzer					
	Systems Engineering 1 (Syst. Engineering I)	2/2/0/0			PVL: Übungsaufgaben PL Klausur 60 min								Systems Engineering (Syst. Engineering)	2/2/0					Klausur 60 min		
NES-12 09 01-14.1	Stochastic Signals and Systems	2/2/0/0 PL			M _{alt} = PL	6	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-StSig	Stochastic Signals and Systems	2/2/0 PL			M _{neu} = PL	6	Prof. Schaefer Dr. Kortke					
	Stochastic Signals and Systems (Sto. Sig.+Sys.)	2/2/0/0			PL Klausur 90 min								Stochastic Signals and Systems (Sto. Sig.+Sys.)	2/2/0					Klausur 90 min		
NES-12 10 02-14.1	Communications		2/1/0/0 PL		M _{alt} = PL	3	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-Comms	Communications		2/1/1 PL		M _{neu} = PL	5	Prof. Fettweis					
	Communications (Communications)		2/1/0/0		PL Klausur 120 min								Communications (Communications)				2/1/1		Klausur 120 min Bonusleistung zur Klausurarbeit: Übungsaufgaben 20 h		
NES-12 10 20	Communication Networks 3 (im Diplom: Kommunikationsnetze, Vertiefungsmodul)			4/2/0/0	M _{alt} = (PL1 + PL2) / 2	7	ÜL M zweitrangig PL	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-FCN (Eul-ET-E-FCN, Eul-IST-E-FCN)	Future Communication Networks			2/1/1 2 PL	M _{neu} = (3 PL1 + PL2) / 4	5	Jun.-Prof. Bassoli					
	Kommunikationsnetze 3 = Communication Networks 3 (ComNets 3)			3/0/0/0	PL1 bei mehr als 15 TN Klausur 120 min, bei bis zu 15 TN mdl. PL 30 min					ÜL PL1			Communication Networks 3 (ComNets 3)					2/1/1	PL1 Klausur 120 min, bis zu 15 TN mdl. PL 30 min PL2 Komplexe Leistung 40 h		
	ComNets - Problem Based Learning (Actual Topics)			1/2/0/0	PL2 Projektarbeit 30 h					ÜL PL2											
NES-12 10 06-14.1	Integrated Photonic Devices for Communications and Signal Processing			4/0/0/2 2PL	M _{alt} = (PL1 + PL2) / 2	7	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-IPD	Integrated Photonic Devices for Communications and Signal Processing			4/0/2 PL	M _{neu} = PL	7	Prof. Jamshidi					
	Integrated Photonic Devices (Photonic Devices)			4/0/0/2	PL1 Beleg 30 h PL2 mdl. PL 30 min								Integrated Photonic Devices (Photonic Devices)					4/0/2	Komplexe Leistung 30 h		
NES-12 08 07	VLSI Processor Design		2/2/0/2		M _{alt} = (2PL1 + PL2)/3	7	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-VLSI (Eul-ET-E-VLSI, Eul-IST-E-VLSI)	VLSI Processor Design		2/2/2 PL		M _{neu} = PL	7	Prof. Mayr					
	VLSI Processor Design		2/2/0/2		PL1 Projektarbeit 30 h PL2 Referat 20 min								VLSI Processor Design (VLSI-ProcDesign)				2/2/2		Komplexe Leistung 50 h		
NES-13 14 01-14.1	Nanotechnology and Material Science		4/2/0/2		M _{alt} = (PL1 + PL2 + PL3) / 3	12	ÜL M zweitrangig PL	M _{neu} = M _{alt}	MW-NES-E-NSM	Nanostructured Materials		2/2/2 2 PL		M _{neu} = (PL1 + PL2) / 2	7	Prof. Cuniberti					
	Nanostructured Materials (Nanostruct. Mat.)			2/2/0/2	PL1 Klausur 90 min/ mdl. PL 20 min (Cuniberti) PL3 Praktikumsbericht (Cuniberti)					ÜL PL1 ÜL PL3	PL1=PL1 PL2=PL3		Nanotechnology (Nanotech.)				2/0/0		PL1 Klausur 90 min, bei bis zu 10 TN mdl. PL 20 min PL2 Komplexe Leistung 10 h		
	Nanotechnology (Nanotech.)			2/0/0/0	PL2 mdl. PL 20 min					PL2 Zusatzbereich auf Antrag			PHY-NES-E- NanSc	Nanoscience				4/0/0 PL	M _{neu} = PL	6	Prof. Eng Physik
													Nanotechnology (Nanotech.)				2/0/0		Klausur 90 min, bei bis zu 10 TN mdl. PL 20 min		
										Scanning Probe Microscopy (SPM)		2/0/0									
NES-12 08 06	Neuromorphic VLSI Systems		4/2/0/0		M _{alt} = (2PL1 + PL2)/3	7	ÜL M zweitrangig PL	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-NVLSI (Eul-ET-E-NVLSI, Eul-IST-E-NVLSI)	Neuromorphic VLSI Systems		4/2/0 2 PL		M _{neu} = (2 PL1 + PL2) / 3	7	Prof. Mayr					
	Neuromorphic VLSI Systems		4/2/0/0		PL1 Beleg PL2 Referat					ÜL PL1 ÜL PL2			Neuromorphic VLSI Systems (Neurom.VLSI-Sys)				4/2/0		PL1 Portfolio 30 h PL2 mdl. PL 20 min		

NES-30 GLC-14.1	German Language and Culture	0/0/4/0 PL			M _{alt} = PL		4	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-GLC	German Language and Culture	4 SK PL			M _{neu} = PL	5	Frau Ruszo
	German Language and Culture (<i>Deutsch als Fremdsprache</i>)	0/4/0/0			PL Klausur 90 min						German Language and Culture (<i>Deutsch als Fremdsprache</i>)	0/4/0			Klausur 60 min		
NES-INF-DSE-20-E-SFT	Foundations of Software Fault-Tolerance		2/2/0/0		M _{alt} = PL		6	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	INF-NES-E-SFT	Software Fault Tolerance		2/2/0 PL		M _{neu} = PL	6	Prof. Fetzer
	Software Fault-Tolerance (<i>Soft.Fault Tol.</i>)		2/2/0/0		PL mdl. 30 min						Software Fault-Tolerance (<i>Soft.Fault Tol.</i>)		2/2/0		mdl. PL 30 min		
NES-11 06 04-14.1	Wireless Sensor Networks		2/2/0/0		M _{alt} = PL		6	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	INF-NES-E-WSN (INF-IST-E-WSN)	Wireless Sensor Networks		2/2/0 PL		M _{neu} = PL	6	Dr. Dargie
	Wireless Sensor Networks (<i>Wireless Sens. Netw.</i>)		2/2/0/0		Klausur 60 min						Wireless Sensor Networks (<i>Wireless Sens. Netw.</i>)		2/2/0		Klausur 60 min		
NES-12 12 03-14.1	Memory Technology		2/1/0/0	2/0/1/0	M _{alt} = PL		7	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-MemTe (Eul-ET-E-MemTe, Eul-IST-E-MemTe)	Memory Technology	2/0/0 1 SWS Seminare	2/0/0 1 SWS Seminare PL	M _{neu} = PL	7	Prof. Mikolajick	
	Memory Technology 1 (<i>Mem.Technol.</i>)		2/1/0/0		PL bei mehr als 20 TN Klausur 90 min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 15 min						Memory Technology 1 (<i>Mem.Technol.</i>)	2/0/0 1 SWS Seminare		Klausur 90 min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 15 min			
	Memory Technology 2 (<i>Memory Technol.</i>)			2/0/1/0							Memory Technology 2 (<i>Memory Technol.</i>)		2/0/0 1 SWS Seminare				
NES-12 06 01-14.1	Materials for the System Integration		2/0/0/0	2/0/0/1	M _{alt} = (PL1 + PL2) / 2		7	ÜL M zweitrangig PL	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-3DSI	Materials for the System Integration		2/0/1 1 Tag	2/0/0 PL	M _{neu} = (PL1 + PL2) / 2	7	Prof. Panchenko
	3D-Systemintegration and 3D Technologies (<i>3D Syst. Integr. a Techn.</i>)		2/0/0/0		PL1 Klausur 90 min			ÜL PL1			Micro-/Nanomaterials and Reliability Aspects (<i>MNM.</i>)		2/0/1		PL2 Komplexe Leistung 32 h		
	Micro-/Nanomaterials and Reliability Aspects			2/0/0/1	PL2 Klausur 90 min PL3 Laborpraktikum (muss bestanden sein)			ÜL PL2 (PL3 bestanden)			3D-Systemintegration and 3D Technologies (<i>3D Syst. Integr. a Techn.</i>)		2/0/0		PL1 Klausur 90 min		
NES-12 12 04-14.1	Electromechanical Networks			2/1/0/0 PL	M _{alt} = PL		4	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-EMNet	Electromechanical Networks			2/1/1 PL	M _{neu} = PL	5	Prof. Marschner
	Electromechanical Networks (<i>El.mech.Netw.</i>)			2/1/0/0	PL Klausur 120 min						Electromechanical Networks (<i>El.mech.Netw.</i>)			2/1/1	Klausur 120 min		
NES-12 08 04-14.1	Integrated Circuits for Broadband Optical Communications			3/1/0/2 PL	M _{alt} = PL		7	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-ICBC (Eul-ET-E-ICBC, Eul-IST-E-ICBC)	Integrated Circuits for Broadband Optical Communications			3/1/2 PL	M _{neu} = PL	7	Prof. Ellinger
	Integrated Circuits for Broadband Optical Communications (ICBC)			3/1/0/2	PL Klausur 120 min						Integrated Circuits for Broadband Optical Communications (ICBC)			3/1/2	Klausur 120 min		
NES-13 14 02-14.1	Molecular Electronics			2/2/0/0	M _{alt} = PL		6	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	MW-NES-E-MoEl	Molecular Electronics			2/2/0 PL	M _{neu} = PL	5	Prof. Erbe
	Molecular Electronics (<i>Mol.Electronics</i>)			2/2/0/0	PL bei mehr als 10 TN Klausur 90 min, bei bis zu 10 TN mdl. PL 20 min						Molecular Electronics (<i>Mol.Electronics</i>)			2/2/0	Klausur 90 min, bei bis zu 10 TN mdl. PL 20 min		(MW Dr. Francesca Moresco)
NES-12 12 05-14.1	Optoelectronics			4/1/0/0 2PL	M _{alt} = (PL1 + PL2) / 2		7	ÜL M zweitrangig PL	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-OPTO	Optoelectronic Devices and Systems			2/1/1 PL	M _{neu} = PL	5	Prof. Lakner
	Nanooptics (<i>Nanooptics</i>)			2/0/0/0	PL1 mdl. PL 20 min			ÜL PL2	M _{neu} = PL2		Optoelectronic Devices and Systems (<i>Optoelectronics</i>)			2/1/1	mdl. PL 20 min Bonusleistung zur mdl. PL ist Praktikumsbericht 15 h		
	Optoelectronic Devices and Systems (<i>Optoelectronics</i>)			2/1/0/0	PL2 schriftl. 60 min oder mdl. PL 20 min			ÜL PL1	M _{neu} = PL1	PHY-NES-E-NanOp	Nano&Optics		4/0/0 PL	M _{neu} = PL	6	Prof. Eng	
	Semiconductor Quantum Structures (<i>Semicond. Qu. Str.</i>)			2/0/0/0	PL mdl. PL 30 min						NanoOptics (<i>Nanooptics</i>) Modern Optics (<i>Mod. Optics</i>)		2/0/0	Klausur 90 min, bei bis zu 10 TN mdl. PL 20 min		Eng Reineke	
	Quantum and Solid State Physics (<i>Sol. St. And Qu. Phys</i>)			3/1/0/0							Semiconductor Quantum Structures (<i>Semicond. Qu. Str.</i>) Quantum and Solid State Physics (<i>Sol. St. And Qu. Phys</i>)		2/0/0	mdl. PL 30 min		Helm, PHY G. Cuniberti / N. Tverdokhle	
NES-12 10 08	Introduction to Optical Nonclassical Computing: Concepts and Devices		4/2/0/0		M _{alt} = (PL1 + PL2) / 2		7	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-ONC (Eul-IST-E-ONC)	Introduction to Optical Non-classical Computing: Concepts and Devices		4/2/0 PL	M _{neu} = PL	7	Prof. Jamshidi	
	Introduction to Optical Nonclassical Computing: Concepts and Devices		4/2/0/0		PL1 mdl. PL 30 min PL2 Präsentation 20 min						Introduction to Optical Nonclassical Computing: Concepts and Devices (<i>Concepts and Devices</i>)		4/2/0	Komplexe Leistung 30 h			
NES-11 20 19	Design and Programming of Embedded Multicore Architectures		2/2/0/0 PL		M _{alt} = PL		6	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	INF-NES-E-EMA (INF-IST-E-EMA)	Design and Programming of Embedded Multicore Architectures		2/2/0 PL	M _{neu} = PL	6	Prof. Göhringer	
	Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen (<i>Entwurf/Prog. Multico</i>)		2/2/0/0		PL Klausur 60 min, bei bis zu 10 TN mdl. 20 min.						Design and Programming of Embedded Multicore Architectures (<i>Entwurf/Prog. Multicore</i>)		2/2/0	Klausur 60 min			
NES-11 20 20	Hardware Modeling and Simulation			2/2/0/0 PL	M _{alt} = PL		6	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	INF-NES-E-HMS (INF-IST-E-HMS)	Hardware Modeling and Simulation		2/2/0 PL	M _{neu} = PL	6	Prof. Göhringer	
	Hardware Modeling and Simulation (<i>Hardware Modellierung</i>)			2/2/0/0	PL Klausur 60 min, bei bis zu 10 TN mdl. 20 min						Hardware Modeling and Simulation (<i>Hardware Modellierung</i>)		2/2/0	Klausur 60 min			
NES-12 10 05-20.1	Antennas and Radar Systems		4/2/0/0 PL		M _{alt} = PL		7	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-ARS	Antennas and Radar Systems		4/2/0 PL	M _{neu} = PL	7	Prof. Plettemeier	
	Antennas		2/1/0/0		PL mdl. 45 min						Antennas		2/1/0	mdl. PL 45 min			
	Radar Systems and Remote Sensing (<i>Radartechnik</i>)		2/1/0/0								Radar Systems and Remote Sensing (<i>Radartechnik</i>)		2/1/0				

NES-30 GLC-14.1	German Language and Culture	0/0/4/0 PL			M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-GLC	German Language and Culture	4 SK PL			M _{neu} = PL		Frau Ruszo
	German Language and Culture (Deutsch als Fremdsprache)	0/4/0/0			PL Klausur 90 min	4				German Language and Culture (Deutsch als Fremdsprache)	0/4/0			Klausur 60 min	5	
NES-12 08 01-20.1	Future Computing Strategies in Nanoelectronic Systems			2/1/0/0 PL	M = PL				entfällt							
				2/1/0/0	PL Klausur 90 min, bei bis zu 5 TN mdl. 30 min	4	PL Zusatzbereich auf Antrag, strukturelle Anerkennung									
NES-22-E-NNMHA	Neural Networks and Memristive Hardware Accelerators	2/0/0/0/2 2 Projekt 2PL			M _{alt} = (4 PL1 + PL2) / 5		ÜL M zweitrangig PL	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-NNMHA (Eul-IST-E-NNMHA)	Neural Networks and Memristive Hardware Accelerators	2/0/2 2 SWS Projekte			M _{neu} = (4 PL1 + PL2) / 5 PL1 ist bestehensrelevant!		Prof. Tetzlaff
	Neural Networks and Memristive Hardware Accelerators [Neur. Net. u. Memr. H. Acc.] Pythonkurs für Ingenieurinnen [Python for Engineers]	2/0/0/0/0 2 SWS Projekt			PL1 mdl. 15min, ab 15 TN Klausur 180 min	7	ÜL PL1			Neural Networks and Memristive Hardware Accelerators [Neur. Net. u. Memr. H. Acc.] Pythonkurs für Ingenieurinnen [Python for Engineers]	2/0/0 2 PR			PL1 Klausur 180 min	7	Schroedter, Seitz
		0/0/0/0/2			PL2 Präsentation		ÜL PL2				0/0/2			PL2 Komplexe Leistung 60 h		Knoll
NES-E-LSer-23	Requirements and methodologies for design of integrated circuits from industrial production perspective			4/0/0/0 PL	M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-LSer	Requirements and methodologies for design of integrated circuits from industrial production perspective			4/0/0 PL	M _{neu} = PL		Prof. Schulz
	Requirements and methodologies for design of integrated circuits from industrial production perspective			4/0/0/0	Klausur 90 min	5				Requirements and methodologies for design of integrated circuits from industrial production perspective			4/0/0	Klausur 90 min Komplexe Leistung 40 h		
NES-E-DNNH-23	Deep Neural Network Hardware			2/2/0/0 PL	M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-DNNH (Eul-IST-E-DNNH)	Deep Neural Network Hardware			2/2/0 PL	M _{neu} = PL		Prof. Mayr
	Deep Neural Network Hardware			2/2/0/0	Klausur 90 min	5				Deep Neural Network Hardware (DeepNeuNet/Hardw)			2/2/0	Klausur 90 min		
NES-E-PD-23	Physical Design			2/0/0/1 2PL	M _{alt} = (2 PL1 + PL2) / 3				Eul-NES-E-PD	Physical Design			2/0/1 PL	M _{neu} = PL		Prof. Fettweis
	Physical Design			2/0/0/1	schriftlicher Bericht Präsentation 15 min	6				Physical Design (Physical Design)			2/0/1	Komplexe Leistung 30 h		Sen Padmanava/ Sebastian Haas
NES-E-ResM-23	Resource Management			2/0/0/0 2 SWS PR PL	M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	WIWI-NES-E-ResM	Resource Management			2/0/0 2 SWS Projekte PL	M _{neu} = PL		Prof. Günther
	Resource Management			2/0/0/0 2 SWS PR	Projektarbeit 90 h	5				Resource Management (Res.-mgt)			2/0/0 2 SWS Projekte	Komplexe Leistung 80 h		
NES-ET-E-PlaTe	Plasma Technology			4/2/0/0 PL	M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-PlaTe	Plasma Technology			4/2/0 PL	M _{neu} = PL		Prof. von Hauff
	Plasma Technology (Plasma Technology)			4/2/0/0	Klausur 90 min	7				Plasma Technology (Plasma Technology)			4/2/0	Klausur 90 min		Hauff/ Hinz
NES-E-JCAS	Joint Communications and Sensing Systems for 6G Networks	2/2/0/0 PL			M = PL				entfällt							
	Joint Communications and Sensing Systems for 6G Networks (Joint comm. 6G)	2/2/0/0			Klausur 90 min	5	PL Zusatzbereich auf Antrag, strukturelle Anerkennung									
NES-INF-E-FCPL	Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design			2/2/0/0 PL	M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-FCPL	Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design			2/2/0 PL	M _{neu} = PL		Dr. Ertel
	Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design (FCPLCD)			2/2/0/0	PL mdl. nicht öffentliche Einzelprüfung 30 min	6				Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design (FCPLCD)			2/2/0	mdl. PL 30 min, ab 15 TN mdl. PL 20 min		
NES-ET-E-ComLS-23	Computational Laser Systems			3/1/0/0 PL	M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-ComLS (Eul-ET-E-ComLS, Eul-IST-E-ComLS, Eul-MT-E-ComLS)	Computational Laser Systems			3/1/0 PL	M _{neu} = PL		Prof. Czarske
	Digitale Holographie und Bildverarbeitung (Holografie)			1/1/0/0	PL mdl. PL 30 min	5				Digitale Holographie und Bildverarbeitung (Holografie)			1/1/0	mdl. PL 30 min		
	Biomedical Laser Systems and Optogenetics (Biomed. System. u. Optogenetik)			2/0/0/0						Biomedical Laser Systems and Optogenetics (Biomed. System. u. Optogenetik)			2/0/0			
NES-E-AJCAS	Applied Joint Communications and Sensing Systems			2/2/0/0 PL	M _{alt} = PL				entfällt							
	Applied Joint Communications and Sensing Systems			2/2/0/0	Klausur 90 min	5	PL Zusatzbereich auf Antrag, strukturelle Anerkennung									

NES-30 GLC-14.1	German Language and Culture	0/0/4/0 PL			M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-GLC	German Language and Culture	4 SK PL			M _{neu} = PL		Frau Ruszo
	German Language and Culture (Deutsch als Fremdsprache)	0/4/0/0			PL Klausur 90 min	4				German Language and Culture (Deutsch als Fremdsprache)	0/4/0			Klausur 60 min	5	
NES-E-AdLsy	Adaptive Laser Systems		2/1/0/1 2 PL		M _{alt} = (3 PL1 + PL2) / 4		ÜL M zweitrangig PL ÜL PL1	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-AdLsy	Adaptive Laser Systems		2/1/1 2 PL		M _{neu} = (3 PL1 + PL2) / 4		Prof. Czarske
	Laser Metrology and Quantum Technology (Lasermesst.)		2/1/0/0		PL1 mdl. PL 20 min	5				Laser Metrology and Quantum Technology (Lasermesst.)		2/1/0		PL1 mdl. PL 20 min PL2 Portfolio 20 h	5	
	Praktikum Lasersensorik (Laser Sensor Technology Lab) (Laserpraktikum)		0/0/0/1		PL2 Praktikum bzw. Portfolio 20 h		ÜL PL2			Praktikum Lasersensorik (Laserpraktikum)		0/0/1				
NES-E-ACSR	Adaptive Computing Systems for Robotics		2/2/0/0 PL		M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	INF-NES-E-ACSR	Adaptive Computing Systems for Robotics		2/2/0 PL		M _{neu} = PL		Prof. Göhringer
	Adaptive Computing Systems for Robotics		2/2/0/0		Klausur 60 min, bis zu 20 TN mdl. PL als Einzelprüfung 20 min	6								Klausur 60 min, bei bis zu 10 TN mdl. PL 20 min	6	
Eul-NES-E-HJCAS	Joint Communication and Sensing RF Hardware			2/0/0 1 SWS Tutorium PL	M _{alt} = PL		ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-HJCAS	Joint Communication and Sensing RF Hardware			2/0/0 1 SWS Tutorium PL	M _{neu} = PL		Prof. Fettweis
	Joint Communication and Sensing RF Hardware (Joint Comm. & Sens. RF Hardware)			2/0/0 1 SWS Tutorium	Klausur 90 min	5				Joint Communication and Sensing RF Hardware (Joint Comm. & Sens. RF Hardware)			2/0/0 1 SWS Tutorium	Klausur 90 min	5	Sen Padmanava
							keine Veränderung		Eul-NES-E-OSO	Organic Semiconductors for Optoelectronics		2/0/0 1 SWS Seminare 2 PL		M = (2 PL1 + PL2) / 3		Prof. Murawski
										Organic Semiconductors for Optoelectronics (OrgSem for Opt)		2/0/0 1 SWS Seminare		PL1 Klausur 60 min, bei bis zu 10 TN mdl. PL Einzelprüfung 20 min PL2 Komplexe Leistung 40 h	5	Saggar
							keine Veränderung		Eul-NES-E-ICDBS (Eul-HST-E-ICDBS)	Integrated Circuit Design for Biomedical Sensors		2/0/2 2 PL		M = (3 PL1 + PL2) / 4 Beide PL sind bestehensrelevant!		Prof. Bahr
										Integrated Circuit Design for Biomedical Sensors (IntegrCircDes)		2/0/2		PL1 Klausur 90 min PL2 Portfolio 80 h	7	
							aus Pflichtmodul -> Wahlpflichtmodul		Eul-NES-E-FED	Fundamentals of Estimation and Detection			2/2/0 PL	M = PL		PD Dr. Rave
										Fundamentals of Estimation and Detection (Fund.Estim.Detc)		2/2/0		Klausur 120 min	6	

	Materials for Nanoelectronics and Vacuum Technology Vacuum Technology (Vacuum Technol.)	4/0/0/1 3xPL			M = (4PL1 + 4PL2 + 2PL3)/10											
	Materials for Nanoelectronics (Mat.for.Nanoel.)	2/0/0			PL1 bei mehr als 20 TN Klausur 90min, bei bis zu 20 TN mdl. Prüfung 30min 151920	6										
		2/0/1			PL2 bei mehr als 20 TN Klausur 90min, bei bis zu 20 TN mdl. Prüfung 30min 151910 PL3 Praktikumsprotokolle 151920											
	High Level Synthesis	2/2/0/0 PL			M = PL											
	High Level Synthesis	2/2/0/0			PL mdl. PL 30min 151110	4										
	Distributed Systems Engineering Systems Engineering 1 (Syst. Engineering I)	2/2/0/0 2/2/0			M = PL PVL: Übungsaufgaben 153901 PL bei mehr als 5 TN Klausur 90min, bei bis zu 5 TN mdl. PL 30min 153900	5										
	Systems Engineering	2/2/0/0			M = PL											

NES-30 GLC-14.1	German Language and Culture	0/0/4/0 PL			M _{alt} = PL	4	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eur-NES-E-GLC	German Language and Culture	4 SK PL			M _{neu} = PL	5	Frau Ruszo
	German Language and Culture <i>(Deutsch als Fremdsprache)</i>	0/4/0/0			PL Klausur 90 min					German Language and Culture <i>(Deutsch als Fremdsprache)</i>	0/4/0			Klausur 60 min		
	Systems Engineering <i>(Syst. Engineering I)</i>	2/2/0/0			PVL: Übungsaufgaben 153901 PL1 Klausur 90min oder Mdl. PL 30min 152010	5										
	Lab VLSI Processor Design Lab VLSI Processor Design		2/2/0/2	2/2/0/2	M = PL PL Projektarbeit 30 h 151510	7										
	Software Fault-Tolerance Software Fault-Tolerance <i>(Soft.Fault Tol.)</i>		2/2/0/0	2/2/0/0	M = PL PVL: Übungsaufgaben 153501 PL bei mehr als 5 TN Klausur 90min, bei bis zu 5 TN mdl. PL 30min 152320	6										
	Software Fault-Tolerance Software Fault-Tolerance <i>(Soft.Fault Tol.)</i>		2/2/0/0	2/2/0/0	M = PL PVL: Übungsaufgaben 153501 PL mdl. PL 30min 153510	6										
	Wireless Sensor Networks Wireless Sensor Networks <i>(Wireless Sens. Netw.)</i>		2/0/2/0	2/0/2/0	M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 Referat 154510 PL2 bei mehr als 10 TN Klausur 90min, bei bis zu 10 TN mdl. PL 30min 154520	6										
	Modeling and Characterization of Nanoelectronic Devices Characterization of mikro- and nanoelectronic devices <i>(Char NE Dev)</i> Modeling of nanoelectronic devices <i>(Mod NE Dev)</i>		4/1/0/1	2/0/0/1 2/1/0/0	M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 Klausur 90min 155410 PL2 Beleg 20h 155420	7										
	Modellierung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente Charakterisierung von mikro- und nanoelektronischen Bauelementen Modellierung von nanoelektronischen Bauelementen		2/0/1	2/1/0 2/1/0	M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 Klausur 90min 155310 PL2 Beleg 20h 155320	7										
	Modeling and Characterization of Electronic Devices		2/2/0/0	0/0/0/2 2/2/0/0 0/0/0/2	M = PL PL Beleg 80h 152310	8										
	Semiconductor Industry Challenges: Market Dynamics - Technology Innovations - Yield and Reliability Engineering Dynamics and economics of the semiconductor market driven by technological innovations <i>(Semcon Ind Chall)</i> Reliability Engineering and Kinetics of Degradation Processes in Advanced Electronics <i>(Reliab.Engin.)</i>		3/0/0 3xPL	1/0/0 2/0/0	M = (PL1 + 2PL2) / 3 + Exkursion (1Wo. in vorlesungsfreier Zeit) PL1 Beleg 154910 PL2 bei mehr als 20 TN Klausur 90min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 45min 154920	4										
	Computational Photonics Computational Photonics			4/0/2 2xPL 4/0/2	M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 Beleg 155710 PL2 mündl. PL 30 min 155720	7										
	Computer Arithmetic Computerarithmetik			2/2/0/0 PL 2/2/0/0	M = PL PL Mdl. PL 45min 150310	6										
	Hardware/Software Codesign Lab Hardware/Software Codesign Lab <i>(H/S-Codesign)</i>		0/0/0/2 PL	0/0/0/2	M = PL PL Projektarbeit 30h 150910	4										
	Innovative Semiconductor Devices Innovative Semiconductor Devices			2/1/0/0 PL 2/1/0/0	M = PL PL1 bei mehr als 20 TN Klausur 90min, bei bis zu 20 TN mdl. PL 15min 155110	4										

NES-30 GLC-14.1	German Language and Culture	0/0/4/0 PL			M _{alt} = PL	ÜL M	M _{neu} = M _{alt}	Eul-NES-E-GLC	German Language and Culture	4 SK PL			M _{neu} = PL	5	Frau Ruszo
	German Language and Culture <i>(Deutsch als Fremdsprache)</i>	0/4/0/0			PL Klausur 90 min				German Language and Culture <i>(Deutsch als Fremdsprache)</i>	0/4/0			Klausur 60 min		
	Optoelectronics Nanooptics <i>(Nanooptics)</i> Optoelectronic Devices and Systems <i>(Optoelectronic)</i>			4/1/0/0 2xPL (2/1/0/0)	M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 Mdl. PL 20min 153110 (2/0/0/0) PL2 Mdl. PL 20min 153120										7
	Real-Time Systems Real-Time Systems <i>(Real-Time Systems)</i>			2/1/0/0 PL 2/1/0/0	M = PL PL Mdl. PL 30min 153310										6
	Theory of Nonlinear Networks Theory of Nonlinear Networks <i>(Th. Nonl. NW)</i>			2/1/0 PL 2/1/0	M = PL PL1 Klausur 90min, bei bis zu 10 TN mdl. 30 Min. 154110										4
	Ubiquitous Information Systems Distributed Systems <i>(Distr. Systems)</i> Mobile Communication and mobile computing <i>(Mob. Communic.)</i>			4/2/0/0 PL 2/2/0/0 2/0/0/0	M = PL PL bei mehr als 10 TN Klausur 120min, bei bis zu 10 TN mdl PL 30min 154310										9
	Investing in a Sustainable Future Investing in a Sustainable Future		1/0/2/0 PL 1/0/2/0		M = PL PL Klausur 90min 151340										4
	Investing in a Sustainable Future Investing in a Sustainable Future		1/0/2/0 3PL 1/0/2/0		M = (2 PL1 + PL2 + PL3) / 4 PL1 Projektarbeit 45h 151310 PL2 Kolloquium 20min 151320 PL3 mdl. PL 20min 151330										4
	Innovative Concepts for active nanoelectronic Devices Innovative Concepts for active nanoelectronic Devices		4/2/0 2PL 4/2/0		M = (PL1 + PL2) / 2 PL1 mdl. PL 15min 87710 PL2 Klausur 90min 87720										4
	Modeling and Simulation of Telecommunication Systems Modeling and Simulation of Telecommunication Systems			2/1/0/0 PL 2/1/0/0	M = PL PL Klausur 120min 152510										9
	Embedded Hardware Systems Design		2/2/0/0 PL		M = PL PL mdl. 30min										6
	Lab Embedded Hardware Systems Design			0/0/0/4 PL	M = PL Projektarbeit 90 Stunden										6